

金-硅面垒型半导体探测器

@唐璞山\$复旦大学 @吴治华\$复旦大学

收稿日期 1962-11-20 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文扼要地叙述了金-硅面垒探测器的制备工艺过程,并对此探测器的各种性能,包括伏安特性、势垒电容、噪声、对Po~(210)源 α 粒子的响应讯号、能量分辨率、温度效应和 γ 辐照效应等方面作了比较系统的测量。对结果进行了讨论。同时利用测得的结果探讨了一些探测器本身的半导体性能,如平均电离能 ϵ_0 和材料的寿命 τ 等。最后介绍了用表面复盖有硼膜和铀层的这种探测器记录中子的情况。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(1023KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者